色散效应对钝化硅太阳电池减反射膜系设计的影响

王安祥1,张晓军1,李继军2

(1. 西安工程大学 理学院,陕西 西安 710048;
 2. 内蒙古工业大学 理学院,内蒙古 呼和浩特 010051)

摘 要:在考虑折射率色散效应基础上,以加权平均反射率作为评价函数,通过智能优化算法对空 间硅太阳电池减反射膜进行优化设计,得到了最佳的膜厚参数,并与不考虑色散下设计的减反射膜 进行了比较。对 MgF₂/TiO₂, SiO₂/TiO₂ 双层减反射膜, 与不考虑色散情形相比, 考虑色散下优化后的 池的 MgF₉/TiO₉,SiO₉/TiO₉减反射膜重新优化设计,与不考虑色散情形相比,考虑色散下优化后的 最小加权平均反射率分别减小了43.9%和33.7%;对具有不同厚度钝化层的空间硅太阳电池,在考 虑色散下进行了减反射膜的优化设计。结果发现,随着钝化层厚度的增加,所得减反射膜的最小加 权平均反射率也随之增大,减反射效果越来越弱。最后,在考虑与未考虑色散情形下,将钝化层膜 厚也作为反演参量后重新设计。结果表明:在色散情形下所设计的减反射膜更佳,对于 MgF2/TiO2/ SiO₂(钝化层)膜系,最佳膜厚参量为 d₁(MgF₂)=97.6 nm, d₂(TiO₂)=40.2 nm, d₃(SiO₂)=4.9 nm; 对于 SiO₂/TiO₂/SiO₂(钝化层),最佳膜厚参量为 d₁(SiO₂)=85.1 nm, d₂(TiO₂)=43.4 nm, d₃(SiO₂)=1.8 nm。 关键词:色散效应; 加权平均反射率; 减反射膜; 硅太阳电池; 智能优化算法 中图分类号: TN304 文献标志码・A DOI: 10.3788/IRLA201847.0621003

Dispersion effect on optimized design of anti-reflection coatings for passivated silicon solar cells dispersion

Wang Anxiang¹, Zhang Xiaojun¹, Li Jijun²

School of Science, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China;
 School of Science, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China)

Abstract: Based on the refractive index dispersion effect, the weighted average reflectivity was used as evaluation function, and the best film thickness parameters of the anti-reflection coatings for the space silicon solar cell was obtained by the intelligent optimization algorithm. The optimization results were compared with that of the anti-reflection coatings designed without considering the dispersion. It displayed that after optimizing, the minimal weighted average reflectivity of the MgF₂/TiO₂ and SiO₂/TiO₂ anti-reflection coatings were reduced by 36.6% and 37.6% under considering the dispersion effect than that without considering dispersion effect. And then the MgF₂/TiO₂ and SiO₂/TiO₂ anti-reflection coatings were deposited on the silicon solar cells with a thickness of 15 nm SiO₂ passivation layer and

收稿日期:2018-01-10; 修订日期:2018-02-20

基金项目:国家自然科学基金(11562016);陕西省自然科学基金(2016JM1018);陕西省教育厅科研项目(16JK1327)

optimized again. Comparing without considering dispersion effect, the minimal weighted average reflectivity in the case of dispersion was reduced by 43.9% and 33.7% for the MgF₂/TiO₂ and SiO₂/TiO₂ coatings with passivation layer, respectively. The optimal design of the anti-reflection coatings were carried out for the space silicon solar cells with different thickness passivation layer. It was found that the minimum weighted average reflectivity of the anti-reflection coatings increased with the increase of the thickness of the passivation layer, meaning that the anti-reflection effect got weaker and weaker. Finally, the anti-reflection coatings were redesigned when the thickness of the passivation layer was also considered as an inversion parameter considering the refractive-index dispersion effect or not. The results show that the anti-reflection film is more optimization by considering the dispersion. For the MgF₂/TiO₂/SiO₂(passivation layer) film system, the optimal film thickness parameters are $d_1(MgF_2)=97.6$ nm, $d_2(TiO_2)=40.2$ nm, d_3 (SiO₂)=4.9 nm. For the SiO₂/TiO₂/SiO₂ (passivation layer) film system, the optimal film thickness parameters are $d_1(SiO_2)=85.1$ nm, $d_2(TiO_2)=43.4$ nm, $d_3(SiO_2)=1.8$ nm.

Key words: dispersion effect; weighted average reflectivity; anti-reflection coating;

silicon solar cell; intelligent optimization algorithm

0 引 言

硅太阳电池是一种把光能转换为电能的半导体光电器件,为了提高硅太阳电池的光电转换效率,在其表面镀减反射膜成为解决这一问题最主要的方法之一^[1],设计减反射膜的关键问题是确定 所选定作为减反射膜材料的膜层厚度,并且结合 硅材料的光谱响应和 AM0 太阳光谱特性,使电池 在所工作的光谱区域内获得最小的加权平均反射 率。

关于太阳电池减反射膜系设计研究已有很多 报道^[2-4],但均没有考虑材料的色散效应,在宽光谱 范围内将材料折射率的取值当作固定常量,由于大 部分减反射膜材料的折射率随波长有较大的变化, 特别是在 300~600 nm 波长范围内变化更为显著, 而且膜层在整个光谱范围内的色散差别不能被忽 略,因此在膜系设计中考虑色散因素极有必要。白 一鸣等人研究了色散效应对晶体硅太阳电池反射 率的影响^[5],将考虑与未考虑色散情形下硅太阳电 池减反射膜的理论计算值分别与实验数据^[6-7]进行 对比,得出色散情形下的反射率与实验数据更相 符,而未考虑色散情形与实验数据相差较大的结 论,但没有进一步开展在膜系优化设计中将色散效 应因素加以考虑的研究。 文中将在考虑晶体硅和减反射膜材料的折射 率色散效应基础上,通过智能优化算法设计包含 SiO₂ 钝化层的 MgF₂/TiO₂,SiO₂/TiO₂ 双层减反射 膜,为空间硅太阳电池减反射膜的优化设计与制备 提供理论上指导。

1 晶体硅及减反射材料的折射率色散

在进行考虑材料折射率色散效应的减反射膜系 设计优化中,首先必须确定晶体硅和减反射膜材料 的色散关系,在确定晶体硅的色散关系中,若采用 Wemple 提出的折射率单振子理论模型^[8],得到晶体 硅在 350~1 100 nm 的折射率随波长增大而单调减 小,而实验测量数据表明在 350~370 nm 波长区域 折射率随波长增大而增大,在370~828.8 nm 波段 折射率随波长增大而减小^[9],由于参考文献[9-10] 所提供晶体硅的折射率实验数据的波长范围有限, 不能得到在 350~1 100 nm 波段完整的折射率色散 数据。因此,这里晶体硅在 349.2~828.8 nm 波段的折 射率采用参考文献[9]的数据,而在830~1100 nm 波段的折射率则通过 Wemple 的折射率单振子理 论模型计算获取,得到硅在350~1100 nm 波段的 折射率色散数据。晶体硅的折射率色散关系如图1 所示,由图1可知,晶体硅在350~370 nm 波长区域 折射率随波长增大而增大,在370~1100 nm 波段

折射率随波长增大而减小。根据文献所给出的在光 谱区域(0.213 86~1.083 0)修正的 Sellmeier 方程^[11], 计算出其所在光谱区域的折射率;SiO₂和 TiO₂的 折射率色散关系也是通过 Wemple 的折射率单振 子理论模型和文献提供的材料参数得到,图 2 为 MgF₂、SiO₂及 TiO₂的折射率色散关系曲线,由图 2 可知,上述几种减反射膜材料在 350~1 100 nm 波 长区域折射率随波长增大而减小。



Fig.1 Refractive-index dispersion relation of crystalline silicon



图 2 三种减反射膜材料的折射率色散关系 Fig.2 Refractive-index dispersion relation of three anti-reflection coatings

2 加权平均反射率的计算与智能优化算法

光学干涉矩阵法是研究多层薄膜理论最广泛 采用的方法^[4],对于膜系基本研究和数值计算,均 具有快捷和普遍的优点。已知 k 层膜系的各层膜材 料的折射率和厚度,分别为 n_j,d_j(j=1,2,…k),入射 介质和基底材料折射率分别为 n₀,n_{k+1}。设光线入射 角为 θ₀,光线在各膜层和基底的折射角 θ_j根据菲涅 耳定律获得:

$$n_0 \sin \theta_0 = n_j \sin \theta_j$$
 (j=1,2,…k, k+1) (1)
第 j 层的干涉特征矩阵为:

$$M_{j} = \begin{bmatrix} \cos \delta_{j} & i \sin \delta_{j} / \eta_{j} \\ i \eta_{j} \sin \delta_{j} & \cos \delta_{j} \end{bmatrix}$$
(2)

式中: δ_j 为第*j*层的相位厚度, $\delta_j = \frac{2\pi}{\lambda} n_j d_j \cos \theta_j$ (*j*= 1,2,…*k*); η_j 为有效折射率。即:

$$\eta_{j} = \begin{cases} n_{j} / \cos \theta_{j} & p \ \Im \\ n_{j} \cos \theta_{j} & s \ \Im \\ \end{bmatrix}$$
(3)

膜系的特征矩阵为:

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \left\{ \prod_{j=1}^{k} \begin{bmatrix} \cos \delta_j & i \sin \delta_j / \eta_j \\ i \eta_j \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_{k+1} \end{bmatrix}$$
(4)

多层膜和基片的组合导纳为 Y=C/B。 从而可计算出光学薄膜的反射率为:

$$R = \left| \frac{1 - Y/\eta_0}{1 + Y/\eta_0} \right|^2 \tag{5}$$

因此,只要已知多层膜系中入射介质、各层膜 及基底的折射率,各层膜的几何厚度,光波入射角 和波长范围,就可计算出该膜系在该波长区域的反 射率。在减反射膜膜系设计中,考虑到 AM0 太阳光 谱功率分布与硅的光谱响应曲线不一致,用它们的 乘积作为权重因子,得到在整个光谱范围内的加权 平均反射率为:

$$R_{w} = \frac{\int_{\lambda_{1}}^{\lambda_{2}} S(\lambda)Q(\lambda)R(\lambda)d\lambda}{\int_{\lambda}^{\lambda_{2}} S(\lambda)Q(\lambda)d\lambda}$$
(6)

式中: $S(\lambda)$ 为 AM0 太阳光谱功率分布; $Q(\lambda)$ 为硅 的光谱响应; $R(\lambda)$ 为减反射膜在对应波长点的反 射率; λ_1 和 λ_2 为光谱波长下限和上限, λ_1 =350 nm, λ_2 =1 100 nm。这里用 5 960 K 黑体辐射光谱模拟 AM0 太阳光谱,图 3、4 分别为晶体硅的内部量子 效率和 AM0 太阳光谱的相对功率分布曲线。



Fig.3 Spectral response of crystalline silicon





Fig.4 Relative power distribution of the AM0 solar spectrum

在空间硅太阳电池表面减反射膜的设计中,所 采用的智能优化算法为遗传模拟退火算法,它是将 遗传算法与模拟退火算法相结合而构成的一种性 能优良的搜索寻优算法,结合了遗传算法优良的全 局搜索特性和退火算法极强的局部搜索特性,由于 遗传模拟退火算法的原理和具体实现步骤在许多 文献中已有详细描述^[11-12],就不再重复说明。这里 考虑色散与未考虑色散情形下减反射膜系设计中 所使用算法的参数设置完全相同,参数如下:编码 形式采用二进制编码,采用单点交叉,群体大小M=100;最大遗传代数 maxgen=200;交叉概率 $p_c=$ 0.7;变异概率 $p_m=0.01$ 。温度参量 $T_0=200$,终止温度 T=1,温度衰减参数 $\alpha=0.85$,马可夫链长度与种群 数相同,也为k=100。

3考虑折射率色散效应下的减反射膜设计 与分析

下面将在考虑折射率色散效应情形下,利用智能优化算法设计空间硅太阳电池表面减反射膜,并 与不考虑色散情形下的结果进行比较。由于考虑折 射率色散效应所得的反射率数值计算结果与实际 情况更接近,因此,在定量评定考虑与未考虑色散 情形下所设计的减反射膜优劣时,将不考虑色散情 形下通过智能算法反演所得膜厚参量,代入考虑色 散下减反射膜加权平均反射率计算公式中得到的 结果,与考虑色散情形下所得减反射膜的加权平均 反射率进行比较。

(1) 双层减反射膜

在考虑折射率色散情形下,分别利用智能优化算法反演出 MgF₂/TiO₂,SiO₂/TiO₂双层减反射膜

的最佳膜层厚度。对于 MgF_2/TiO_2 双层膜, 膜厚 d1(MgF2)=97.1 nm, d2(TiO2)=47.2 nm 时, 有最小 加权平均反射率 $R_{\text{wmin}}=2.63\%$; 对于 SiO₂/TiO₂ 双层 膜,膜厚 d₁(SiO₂)=85.1 nm, d₂(TiO₂)=45.8 nm 时, 有最小的加权平均反射率 R_{wmin}=2.12%。而不考虑 折射率色散效应情形下, MgF₂、TiO₂及SiO₂的折 射率分别为 n (MgF₂)=1.38、n (TiO₂)=2.3 及 n (SiO₂)= 1.46, 基底硅的折射率 n(Si)=3.9, 同样通过智能 优化算法反演出上述双层膜的最佳膜层厚度,对 于 MgF_2/TiO_2 双层 膜, 膜厚 $d_1(MgF_2)=96.2$ nm, d₂(TiO₂)=59.1 nm 时,有最小的加权平均反射率 R'_{wmin}= 1.98%;对于 SiO₂/TiO₂ 双层膜,膜厚 d₁(SiO₂)=88.5 nm, $d_2(\text{TiO}_2)=57.6$ nm 时,有最小的加权平均反射率 $R'_{wmin}=2.55\%$,这里说明一下, R'_{wmin} 为不考虑色散 效应下的加权平均反射率,将上述不考虑折射率色 散效应下膜厚反演参数代入考虑折射率色散下的 加权平均反射率计算公式,得到 MgF₂/TiO₂和 SiO_2/TiO_2 双层膜的加权平均反射率分别为 R_{wmin} = 4.15%和 R_{wmin}=3.40%,都远大于考虑色散情形下的 最小加权平均反射率,表明考虑折射率色散效应后 所设计的减反射膜将更佳。由计算可知,与不考虑 折射率色散效应相比,考虑色散效应下的 MgF₂/ TiO₂,SiO₂/TiO₂双层减反射膜最小加权平均反射 率分别降低了 36.6% 和 37.6%。 图 5、6 分别为考虑 色散与否情形下通过智能优化算法参数反演所获 得的 MgF₂/TiO₂ 与 SiO₂/TiO₂ 减反射膜的反射率, 标识"——"曲线是不考虑色散下通过智能优化算 法反演所得膜厚参量,代入不考虑色散下减反膜反 射率计算公式中所得结果;曲线"-。-"和曲线"-▲-" 分别为考虑和未考虑色散下通过智能优化算法反 演所得膜厚参量,均代入考虑色散下减反射膜的反 射率计算公式中所得结果。比较曲线可知,对于膜 厚确定的减反射膜,考虑与不考虑色散情形下反射 率的差别主要在短波区域,在其他波长范围都相差 较小,特别是 MgF₂/TiO₂ 减反射膜在 700~1 100 nm 波长范围内两种情形的反射率相差极小。从图可 知,在短波范围内,考虑色散下通过智能优化算法反 演所得减反射膜的反射率明显大于未考虑色散下的 结果,而在长波范围内,考虑色散下通过智能优化算 法反演所得反射率小于未考虑色散下的结果。







图 6 SiO₂/TiO₂ 双层减反射膜的反射率随波长的变化曲线 Fig.6 Reflectivity curves of SiO₂/TiO₂ double-layer anti-reflective coating with the wavelengths

(2) 钝化层膜厚固定情形下减反射膜的优化

由于太阳电池要进行表面钝化,上述设计的两 层减反射膜实际很难达到期望的减反射效果,下面 进行考虑有钝化层时双层减反射膜的优化,并通过 智能优化算法对有钝化层电池的减反射膜重新进 行优化设计,这里将双层减反射膜看作是三层膜 (钝化层为膜系的第三层)进行设计,反演出最佳的 膜层厚度,与一般的三层膜设计不同在于钝化层的 参数(折射率 n, 膜厚 d)已经确定。若设计中钝化层 为 SiO₂, 膜厚为 15 nm, 在考虑色散效应情形下, 对 于 MgF₂(97.1 nm)/TiO₂(47.2 nm) 双层膜实际上变 为 MgF₂(97.1 nm)/TiO₂(47.2 nm)/SiO₂(15 nm) 三 层膜,计算此时加权平均反射率 R_{wmin}=7.99%,显然 减反射效果不太理想,将 MgF2、TiO2 膜层厚度作 为反演参量,在考虑折射率色散情形下,通过智能 优化算法参数反演得到膜厚 $d_1(MgF_2)=99.0$ nm, $d_2(\text{TiO}_2)=29.0$ nm 时,有最小的加权平均反射率, R_{wmin}=3.11%,可见考虑色散效应下通过智能优化算 法得到的加权平均反射率降低很多。在不考虑色散 情形下,对于 MgF₂(96.2 nm)/TiO₂(59.1 nm)双层

第47卷

膜实际上变为 MgF₂(96.2 nm)/TiO₂(59.1 nm)SiO₂/ (15 nm) 三层膜,将上述膜层参数代入考虑色散效 应的加权平均反射率计算公式,得到 R_{wmin} = 12.57%。若将膜层厚度作为反演参量,通过智能优 化算法参数反演得到 d₁(MgF₂)=97.6 nm,d₂(TiO₂)= 40.8 nm,将上述膜层参数代入考虑色散效应的加 权平均反射率计算公式,得到 R_{wmin}=5.54%。因此, 对具有钝化层且膜厚为 15 nm 的硅太阳电池的 MgF₂/TiO₂,SiO₂/TiO₂ 减反射膜重新优化设计,与 不考虑色散情形相比,考虑色散下优化后的最小加 权平均反射率分别减小了 43.9%和 33.7%。图7为 上述情形下所设计的 MgF₂/TiO₂(15 nm)减反



图 7 考虑与未考虑色散情形下 MgF₂/TiO₂/SiO₂(15 nm) 减反射膜的反射率

Fig.7 Reflectivity of MgF₂/TiO₂/ SiO₂(15 nm) anti-reflective coatings in the case of considering and without consideration of dispersion

射膜的反射率。可见,加权平均反射率最小所对应的 MgF₂(99.0 nm)/TiO₂(29.0 nm)/SiO₂(15 nm)减反射膜,在 350~610 nm 波长范围内的反射率最小,而在 790~1 100 nm 波长范围内的反射率最大。表 1 和图 8 分别为考虑与未考虑色散情形下SiO₂/TiO₂/SiO₂(15 nm)减反射膜的优化结果和相应的反射率,同样得到在考虑折射率色散情形下,将 SiO₂、TiO₂ 膜层厚度作为反演参量所得 SiO₂(85.9 nm)/TiO₂(28.5 nm)/SiO₂(15.0 nm)减反射膜的加权平均反射率最小,并且该减反射膜在 350~450 nm 波长范围内的反射率在图中四种情形中最小,而在 870~1 100 nm 波长范围内的反射率最大。需要说明一下,表 1 中 *R*_{wmin}=7.99%为优化前后的膜厚参量均代入考虑色散的加权平均反射率公

式所得结果,下文表 2~4 皆是如此。

表 1 具有 15 nm 厚度 SiO₂ 钝化层的硅太阳电池的 SiO₂/TiO₂ 减反射膜的优化

Tab.1 Optimization of SiO₂/TiO₂ anti-reflection

coating for silicon solar cell with a

thickness of 15 nm SiO₂ passivation layer

	Without dispersion	With dispersion
Before optimization	$d_1(SiO_2)=88.5 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=57.6 \text{ nm}$ $d_3(SiO_2)=15.0 \text{ nm}$ $R_{wmin}=11.28\%$	$d_1(SiO_2)=85.1 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=45.8 \text{ nm}$ $d_3(SiO_2)=15.0 \text{ nm}$ $R_{\text{sumin}}=7.59\%$
After optimization	$d_1(SiO_2)=90.6 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=40.0 \text{ nm}$ $d_3(SiO_2)=15.0 \text{ nm}$ $R_{smin}=5.55\%$	$d_1(SiO_2)=85.9 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=28.5 \text{ nm}$ $d_3(SiO_2)=15.0 \text{ nm}$ $R_{\text{sumin}}=3.68\%$





Fig.8 Reflectivity of SiO₂/TiO₂/SiO₂(15 nm) anti-reflective coatings in the case of considering and without considering dispersion

(3) 钝化层厚度作为反演参量下减反射膜的优化

由于钝化层 SiO₂ 厚度不同,会影响硅太阳电 池的有效减反作用。在考虑色散情形下,钝化层不 同厚度时通过智能优化算法所得减反射膜的参量 优化结果如表 2 所示,可见钝化层 SiO₂ 厚度越大, 所得减反射膜的加权平均反射率也随之增大,减反 射效果越来越削弱。

下面将 SiO₂ 钝化层的膜厚作为优化参量,在 考虑折射率色散情形下,通过智能算法对多层减反 射膜进行优化设计,这里设定膜层几何厚度搜索范 围为 5~200 nm,表 3 是考虑折射率色散下钝化层 膜厚作为反演参量时减反射膜的优化结果。结果表 明,将钝化层厚度作为反演参量所得减反射膜的加

表 2 考虑色散下对具有不同厚度钝化层的空间 硅太阳电池减反射膜的优化结果

Tab.2 Optimization results of anti-reflection

coatings for space silicon solar cells with different thickness passivation layers

in the case of considering dispersion

		0
Film system	Thickness of passivation layer/nm	Optimization results
MgF ₂ / TiO ₂ / SiO ₂	$d_3(SiO_2)=10.0$	$d_1(MgF_2)=98.2 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=33.9 \text{ nm}$ $R_{wmin}=2.66\%$
	$d_3(SiO_2)=20.0$	$d_1(MgF_2)=99.8 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=25.1 \text{ nm}$ $R_{wmin}=3.96\%$
	$d_3(SiO_2)=30.0$	$d_1(MgF_2)=101.1 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=19.4 \text{ nm}$ $R_{wmin}=6.71\%$
	$d_3(SiO_2)=40.0$	$d_1(MgF_2)=46.3 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=10.3 \text{ nm}$ $R_{wmin}=9.72\%$
SiO ₂ /TiO ₂ / SiO ₂	$d_3(SiO_2)=10.0$	$d_1(SiO_2)=86.2 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=33.0 \text{ nm}$ $R_{wmin}=2.71\%$
	$d_3(SiO_2)=20.0$	$d_1(SiO_2)=87.5 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=24.6 \text{ nm}$ $R_{wmin}=5.11\%$
	$d_3(SiO_2)=30.0$	$d_1(SiO_2)=48.1 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=11.8 \text{ nm}$ $R_{wmin}=8.21\%$
	$d_3(SiO_2)=40.0$	$d_1(SiO_2)=32.9 \text{ nm}$ $d_2(TiO_2)=8.7 \text{ nm}$ $R_{wmn}=9.77\%$

表 3 钝化层厚度作为反演参量时减反射膜的 优化结果

Tab.3 Optimization results of the anti-reflection

coatings when the thickness of the passivation layer is used

as an inversion parameter

Film system	Without dispersion	With dispersion
	$d_1(MgF_2)=96.4 \text{ nm}$	$d_1(MgF_2)=97.6 \text{ nm}$
MgF ₂ /TiO ₂ /	$d_2(TiO_2)=52.6 \text{ nm}$	$d_2(\text{TiO}_2)=40.1 \text{ nm}$
SiO_2	$d_3(SiO_2)=5.0 \text{ nm}$	$d_3(SiO_2)=5.0 \text{ nm}$
	$R_{wmin} = 4.39\%$	$R_{\text{wmin}}=2.54\%$
	$d_1(SiO_2)=88.7 \text{ nm}$	$d_1(SiO_2) = 85.6 \text{ nm}$
SiO ₂ /TiO ₂ /	$d_2(TiO_2)=51.1 \text{ nm}$	$d_2(\text{TiO}_2)=38.9 \text{ nm}$
SiO_2	$d_3(SiO_2)=5.0 \text{ nm}$	$d_3(SiO_2)=5.0 \text{ nm}$
	$R_{wmin} = 3.69\%$	$R_{\rm wmin}$ =2.21%

权平均反射率比表 2 中不同钝化层厚度下减反膜 优化结果中加权平均反射率要小。从两种膜系的优 化结果来看,考虑折射率色散效应的加权平均反射 率小于未考虑折射率色散效应的情形。而且考虑和 未考虑色散效应情形下钝化层的优化结果均为膜 层厚度搜索范围的下限值。

若将膜层几何厚度搜索范围为 0~200 nm,所 得减反射膜的优化结果如表 4 所示,从不考虑折射 率色散效应的优化结果来看,所得两种减反射膜的 钝化层厚度均为零,最终其他参量优化结果与双层 减反射膜的优化结果完全相同。而从考虑折射率色 散效应优化结果来看,钝化层作为反演参量所得减 反射膜的加权平均反射率要小于钝化层厚度固定 情形下的结果。但是所得钝化层 SiO₂ 厚度太小,不 仅镀膜工艺实现困难,而且表面钝化作用也减弱。

表 4 钝化层厚度作为反演参量时减反射膜的 优化结果

Tab.4 Optimization results of the anti-reflection coatings when the thickness of

the passivation layer is used

as an inversion parameter

Film system	Without dispersion	With dispersion
	$d_1(MgF_2)=96.2 \text{ nm},$	$d_1(MgF_2)=97.6 \text{ nm},$
MgF ₂ /TiO ₂ /	$d_2(\text{TiO}_2)=59.1 \text{ nm}$,	$d_2(\text{TiO}_2)=40.2 \text{ nm}$,
SiO_2	$d_3(SiO_2)=6.3 \times 10^{-8} \text{ nm}$	$d_3(SiO_2)=4.9 \text{ nm}$
	$R_{wmin} = 4.15\%$	$R_{\text{wmin}}=2.54\%$
	$d_1(SiO_2) = 88.5 \text{ nm}$,	$d_1(SiO_2)=85.1 \text{ nm}$,
SiO ₂ /TiO ₂ /	$d_2(\text{TiO}_2) = 57.6 \text{ nm}$,	$d_2(\text{TiO}_2)=43.4 \text{ nm}$,
SiO_2	$d_3(SiO_2)=1.1\times10^{-7}$ nm	$d_3(SiO_2)=1.8 \text{ nm}$
	$R_{\rm wmin} = 3.40\%$	$R_{\rm wmin}$ =2.10%

图 9、10 分别为考虑色散下五种钝化层不同厚







度的 MgF₂/TiO₂、SiO₂/TiO₂ 减反射膜反射率优化曲线,钝化层厚度越小,所得优化减反射膜的反射率在短波区域越小,而在长波区域越大,当钝化层的厚度大于 30 nm 时,减反射膜的减反射效果将会越来越差。



图 10 考虑色散下具有五种厚度钝化层的 SiO₂/TiO₂ 减反射膜优化后反射率随波长变化曲线

Fig.10 Curves of the reflectivity of optimized SiO₂/TiO₂ antireflection coatings with the wavelengths under five thickness passivation layers in the case of considering dispersion

尽管上述研究获得了在考虑色散情形下空间 硅太阳能电池减反射膜的最佳膜厚参量,但是在实 际镀膜过程中所镀膜厚并不能与计算结果完全相 同,图 11、12 分别为 MgF₂(97.6 nm)/TiO₂(40.2 nm)/ SiO₂(4.9 nm)和 SiO₂(85.1 nm)/TiO₂(43.4 nm)/ SiO₂(1.8 nm)减反射膜系的加权平均反射率随各层 膜厚偏差的变化曲线。从图中可以看到,当各膜层 厚度偏离理论设计值时,膜系的加权平均反射率都 会明显增加,其中钝化层厚度对膜系的加权平均反射 率影响最大,而最上层膜的厚度对加权平均反射 率影响最小。以 MgF₂(97.6 nm)/TiO₂(40.2 nm)/ SiO₂(4.9 nm)减反射膜为例,其最小加权平均反射



图 11 加权平均反射率随 MgF₂, TiO₂和 SiO₂ 钝化层膜厚的变化 Fig.11 Weighted average reflectivity as a function of thickness of MgF₂, TiO₂ and SiO₂ passivation layer



图 12 加权平均反射率随 SiO₂、TiO₂和 SiO₂ 钝化层膜厚的变化 Fig.12 Weighted average reflectivity as a function of thickness of SiO₂, TiO₂ and SiO₂ passivation layer

率 R_{wmin} =2.54,当 MgF₂ 厚度加减 2 nm 时,加权平 均反射率 R_w 都增至 2.55%;当 TiO₂ 厚度加减 2 nm 时,加权平均反射率 R_w 都增至 2.60%;当钝化层 SiO₂ 厚度加减 2 nm 时,加权平均反射率 R_w 也都增至 2.66%。所以如需控制膜系加权平均反射率小于 2.60%,实际镀膜时,膜厚精度应控制在 2 nm 以内。

4 结 论

文中在考虑折射率色散效应的基础上,通过智 能优化算法对空间硅太阳电池减反射膜进行了设 计,得到了加权平均反射率最小时减反射膜的最 优化厚度及反射率曲线,并与未考虑折射率色散 效应下所设计的减反射膜系进行了比较,然后分 析在考虑色散情形下, 钝化层不同厚度时通过智 能优化算法所得减反射膜的参量优化结果,最后 将 SiO₂ 钝化层膜厚也作为优化参量,在考虑折射 率色散情形下,通过智能算法对多层减反射膜进 行优化设计,结果表明:考虑色散下所得到的加权 平均反射率要小于未考虑色散下所得到的加权平 均反射率,考虑色散下减反射膜的反射率在短波 区域的减反射效果得到很大改善;随着钝化层厚 度的增加,所得减反射膜的加权平均反射率也随 之增大,减反射效果越来越减弱;钝化层作为反演 参量所得减反射膜的加权平均反射率要小于钝化 层膜厚固定时所得减反射膜的加权平均反射率。 因此,考虑折射率色散效应将会有助于设计出更 优化的减反射膜,以便为空间硅太阳电池减反射 膜的制备提供理论上的依据,更有效地提高太阳 电池的转换效率。

致谢:

感谢上海电力学院太阳能研究所刘永生老师 所提供的硅的光谱响应数据。

参考文献:

- Yang Wenhua, Wu Dingxiang, Li Hongbo. Design and numerical analysis of anti-reflection coatings for space highefficiency Si solar cells [J]. *Chinese Journal of Semiconductors*, 2004, 25(9): 1118–1122. (in Chinese)
- [2] Gong Chen, Zhang Jingquan, Feng Lianghuan, et al. The optimization of triple layer anti-reflection coatings and its application on solar cells [J]. *Journal of Function Materials*, 2013, 44(4): 603–606. (in Chinese)
- [3] Sun Xipeng, Xiao Zhibin, Du Yongchao. Design of broadband antireflection coating for new gallium arsenide solar cell [J]. *Acta Optica Sinica*, 2016, 36(4): 0431002. (in Chinese)
- [4] Liu Yongsheng, Yang Wenhua, Zhu Yanyan, et al. Design of new nano anti-reflection coating for space silicon solar cells
 [J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(7): 4992–4996. (in Chinese)
- [5] Bai Yiming, Chen Nuofu, Peng Changtao, et al. Refractiveindex dispersion effect on anti –reflection coatings of crystalline Si solar cells [J]. Acta Photonica Sinica, 2007, 36(7): 1202–1206. (in Chinese)
- [6] Bouhafs D, Moussi A, Chikouche A, et al. Design and simulation of antireflection coating systems for opoelectronic devices: application to silicon solar cells [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1998, 52: 79–93.
- [7] Cid M, Stem N, Brumetti C, et al. Improvements in antireflection for high –efficiency silicon solar cells [J]. Surface and Coatings Technology, 1998, 106: 117–120.
- [8] Wemple S H, Didomenico M. Behavior of the electronic dielectric constant in covalent and ionic materials [J]. *Phys. Rev B*, 1971, 3(4): 1338–1351.
- [9] Palik E D. Handbook of Optical Constants of Solids [M]. New York: Academic Press, 1985: 557–561.
- [10] Li Jingzhen. Handbook of Optics [M]. Xi' an: Press of Science in Shanxi, 1986. (in Chinese)
- [11] Wang Anxiang, Zhang Xiaojun, Cao Yunhua. Application of genetic simulated annealing alrorithm in parameters retrieval of dispersion equation for glass and crystal [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(11): 3197–3203. (in Chinese)
- [12] Wang Anxiang, Feng Jian. Genetic simulated annealing algorithm in the parameter retrieval of light scattering model
 [J]. *Laser Technology*, 2009, 33(1): 32–35. (in Chinese)